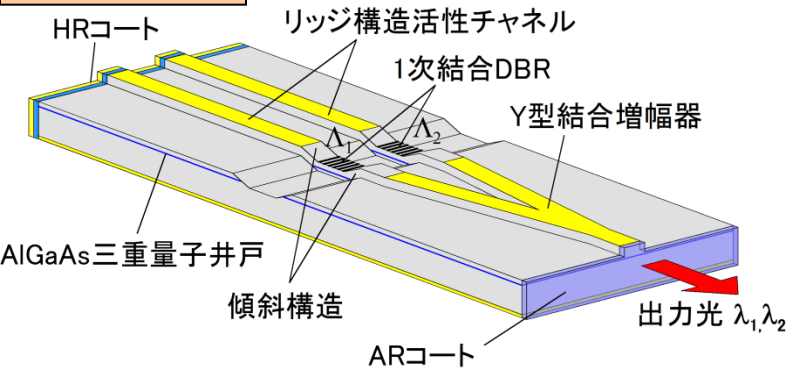
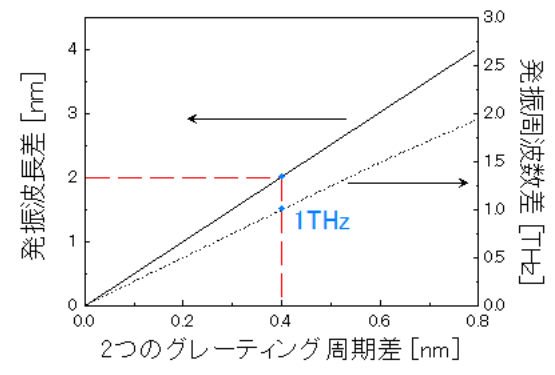


# THz波発生用2波長集積半導体DBRレーザに関する研究

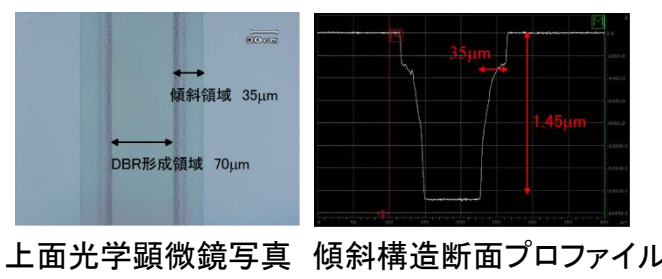
## レーザ構成



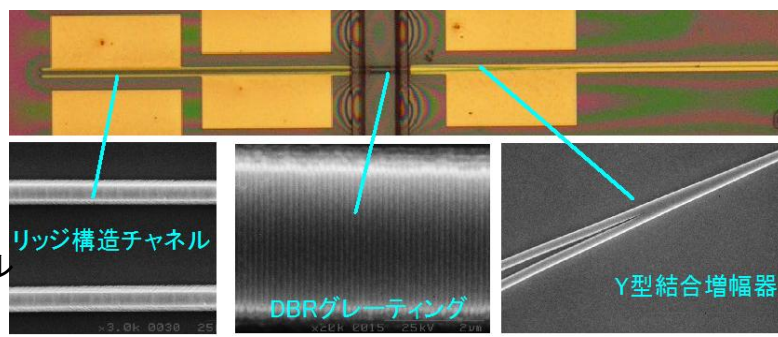
## 2波長集積半導体DBRレーザ



1THzの差周波数 発振波長差 2nm  
DBR周期差 0.4nm

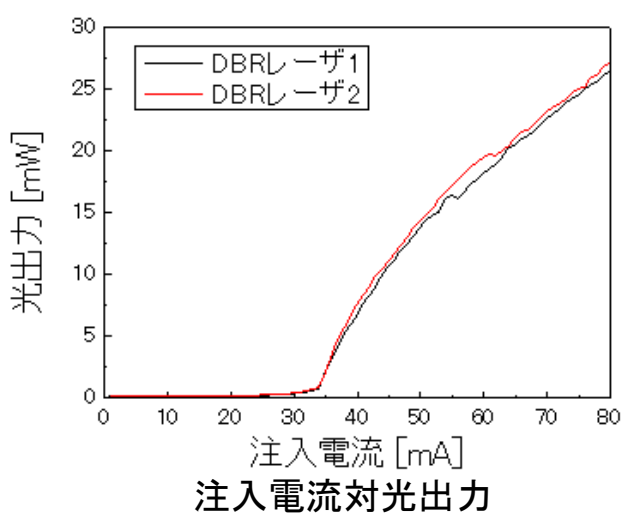


35mmの傾斜構造形成に成功

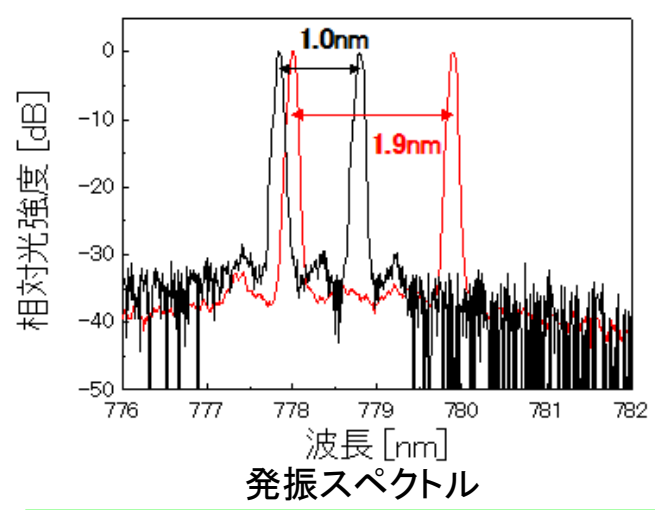


デバイス全体写真および各部SEM写真

## 測定結果



Y型結合器注入電流 50mA  
しきい値電流 33mA  
光出力 26mW以上(注入電流80mA)



設計波長差 発振波長差 差周波数  
1.0nm → 1.0nm 0.5THz  
2.0nm → 1.9nm 0.93THz  
サイドモード抑圧比30dB以上